

固体デバイス・材料国際会議 SSDM2014 参加報告

群馬大学 小林研究室 M2 新井 薫子

会場：Tsukuba International Congress Center (つくば国際会議場)

期間：2014年9月8日～9月11日

International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM, <http://www.ssdm.jp/>) は毎年日本で開催されるデバイス分野の国際学会です。今回、半導体理工学研究センターとの共同研究成果の内容の下記の論文が採択され、9月10日にショートプレゼンテーション(3分間)とポスター発表を行いました。

Yukiko Arai, Hitoshi Aoki, Fumitaka Abe, Shunichiro Todoroki, Ramin Khatami, Masaki Kazumi, Takuya Totsuka, Taifeng Wang, Haruo Kobayashi

“Gate Voltage Dependent $1/f$ Noise Variance Model in n-Channel MOSFETs”

東南アジアやヨーロッパからの発表が多くありました。日本からは大学だけでなく東芝やルネサスエレクトロニクスなど企業の方も多く参加されていました。

ポスターセッションの時間には何人もの方が質問に来てくださいました。 $1/f$ ノイズとはどういうものかという質問や測定したデバイスに関する質問が多くありました。界面トラップや移動度の変動による $1/f$ ノイズばらつきやゲート電圧依存性については以前から言われており、SPICEでのシミュレーションができるようにしてほしいという意見もありました。説明していると私自身がよく分かっていない点が出てきて勉強不足の部分を感じました。ポスター発表の数はとても多くどの発表の前でも議論が白熱していました。

このような大きな国際学会参加は初めてだったのですが、ハイレベルな研究を見ることができ貴重な経験をさせていただきました。



今回の発表にあたり青木先生、小林先生に丁寧にご指導いただきました。ありがとうございました。